

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 02291147  
PUBLICATION DATE : 30-11-90

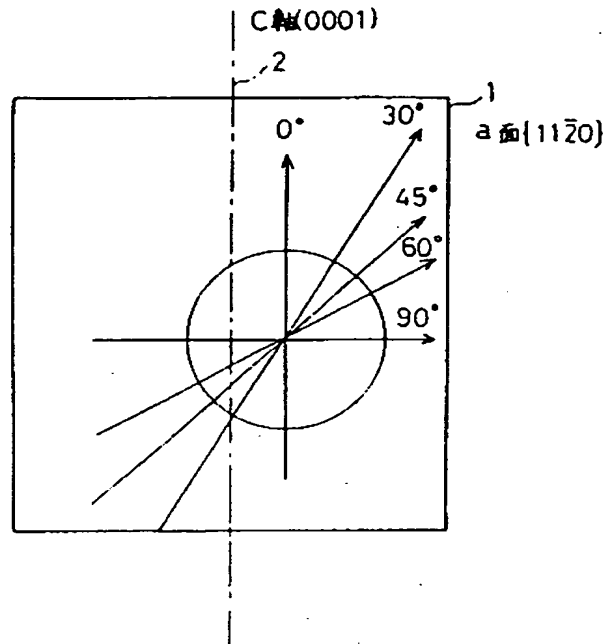
APPLICATION DATE : 29-04-89  
APPLICATION NUMBER : 01110965

APPLICANT : RES DEV CORP OF JAPAN;

INVENTOR : MORI MASAKI;

INT.CL. : H01L 21/78 H01L 21/86

TITLE : MANUFACTURE OF  
SEMICONDUCTOR CHIP USING  
SAPPHIRE AS SUBSTRATE



ABSTRACT : PURPOSE: To prevent chippings, to prevent a defective chip from being produced and to increase the number of chips per wafer by a method wherein a semiconductor is formed on a face (a) of a sapphire substrate and a dicing operation is executed along a boundary crossing an axis (c) of the sapphire substrate at a specific angle.

CONSTITUTION: A rectangular sapphire substrate 1 whose surface is a face (a) and whose long side is an axis (c) is fixed onto a silicon wafer by using a wax. A dicing operation is executed in a direction crossing the axis (c) (0001) at 55° or lower. For the dicing operation, a blade, with a width of 150μm, which has been coated with synthetic diamonds is used. As dicing conditions, the number of revolutions of the blade are set to 24000rpm and a dicing speed is set to 1mm/sec.

COPYRIGHT: (C) JPO

## ⑫ 公開特許公報(A) 平2-291147

⑤ Int. Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

④ 公開 平成2年(1990)11月30日

H 01 L 21/78  
21/86A 6824-5F  
7739-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

⑤ 発明の名称 サファイアを基板とする半導体チップの製造方法

② 特 願 平1-110965

② 出 願 平1(1989)4月29日

⑦ 発 明 者 小 滝 正 宏 愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地 豊田合成株式会社内

⑦ 発 明 者 真 部 勝 英 愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地 豊田合成株式会社内

⑦ 発 明 者 森 正 樹 愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地 豊田合成株式会社内

⑦ 出 願 人 豊田合成株式会社 愛知県西春日井郡春日町大字落合字長畑1番地

⑦ 出 願 人 新技術開発事業団 東京都千代田区永田町2丁目5番2号

⑦ 代 理 人 弁理士 藤 谷 修

## 明 細 書

## 1. 発明の名称

サファイアを基板とする半導体チップの製造方法。

## 2. 特許請求の範囲

サファイアを基板として形成された半導体チップにおいて、

サファイア基板のa面(11 $\bar{2}$ 0)上に半導体を形成すると共に前記サファイア基板のc軸(0001)に対して55度以下の角度で交差する2方向の直線をチップの境界とし、その境界に沿ってダイシングする半導体チップの製造方法。

## 3. 発明の詳細な説明

## 【産業上の利用分野】

本発明はサファイアを基板とする半導体チップの製造方法、特に、ダイシング方法に関する。

## 【従来技術】

従来、サファイアはエピタキシャル成長のための絶縁基板として多用されている。そして、そのサファイア基板上には、半導体回路がエピタキシ

ャル成長により形成される。そして、チップ作製のためのウエハのダイシングには、シリコン等のダイシングと同様に、人造ダイヤモンドを塗布したブレードを高速回転させてダイシングすることが行われている。

## 【発明が解決しようとする課題】

ところが、サファイアは、非常に硬い物質のため、通常のシリコン、ガリウム砒素等をダイシングする条件では、ダイシングが難しい。即ち、幅の広いブレードを使用し、ブレードを高速回転させることや高トルクが必要であった。このため、チップングと呼ばれる切削部分の割れ、欠けが大きく且つ多く発生し、電極等の脱落を生じチップの不良を多数発生していた。又、チップングを考慮して、切り代を大きくとると、1ウエハ当たりで作製できるチップ数が少なくなる。

本発明は、上記の課題を解決するために成されたものであり、その目的とするところは、サファイアを基板とする半導体ウエハのダイシングにおけるチップングを防止し、不良チップの発生を防

止すると共に1ウエハ当たりにできるチップ数を増加させることである。

### 【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するための発明の構成は、サファイアを基板として形成された半導体チップにおいて、サファイア基板のa面(1120)に半導体を形成すると共に前記サファイア基板のc軸(0001)に対して55度以下の角度で交差する2方向の直線をチップの境界とし、その境界に沿ってダイシングすることの特徴とする。

### 【作用及び効果】

本発明者は、実験により、サファイア基板のa面(1120)において、c軸(0001)に対して55度以下の角度で交差する方向に、サファイアをダイシングすると、チップングが最小となることを発見した。したがって、上記の如く、サファイア基板のa面(1120)上であって、c軸(0001)に対して55度以下の角度で交差する2方向の直線をチップの境界として、半導体を結晶成長させ、その境界に沿って切断してチップを分離すると、チップ

ングが少なくなると、チップングが少ないことから、切り代を小さくでき、1ウエハ当たりのチップ数を向上させることができる。

### 【実施例】

以下、本発明を具体的な実施例に基づいて説明する。

第1図に示すように、上面がa面で長辺がc軸である長形状のサファイア基板1を準備した。次に、そのサファイア基板1を6インチのシリコンウエハ上にワックスで固定して、c軸2に対して、0度、30度、45度、60度、90度で交差する方向にダイシングした。ダイシングには人造ダイヤモンドを塗布した幅150μmのブレードが用いられた。ダイシング条件は、ブレードの回転速度24000rpm、ダイシング速度1mm/secであった。そして、そのダイシング溝を観察した。その結果を第2図～第6図に示す。

又、ダイシング幅とダイシング方向との関係を第7図に示す。

第7図の結果から、c軸に対して30度以下で

- 3 -

- 4 -

交わる方向にダイシングする場合には、ダイシングの幅は最小190μmで最大220μmで一定であった。又、ダイシング方向に拘わらずダイシング幅の最小値は190μmで一定であるが、ダイシング幅の最大値はc軸に対して45度を越える方向になると、急激に増加することが分る。

したがって、c軸に対して55度以下で交わる方向にダイシングするとき、良好なダイシングが行われることが理解される。

サファイア基板上に成長した半導体ウエハを正方形又は長方形にダイシングするには、c軸に対して、35度～55度の範囲で傾斜した直交する2方向に行う場合に、良好なチップのダイシングが行われることが分る。

最良モードでは、チップが正方形又は長方形であれば、サファイア基板のa面上において、c軸に対して45度を成す直交する2直線を境界としてダイシングするのが最も良い。

更に、正方形又は長方形のサファイア基板を使用する場合には、c軸に対して各辺が45度とな

るものを使用することにより1ウエハ当たりに作製できるチップ数を増加させることができる。

又、このダイシングは、サファイア基板上にN型の窒化ガリウムとI型の窒化ガリウムを結晶成長させたウエハについても行ったが、チップングに関して上記と同様な結果が得られた。即ち、c軸に対して、55度以下で交わる方向にダイシングするとき、チップングの小さい良好なダイシングが行われた。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図はサファイア基板のダイシング方向を示した説明図、第2図、第3図、第4図、第5図、第6図は、それぞれ、c軸に対して0度、30度、45度、60度、90度に傾斜した方向にダイシングした場合のダイシング溝を示した写真、第7図はダイシング幅の最大値と最小値のダイシング方向に対する関係を示した測定図である。

1 ……サファイア基板 2 ……c軸

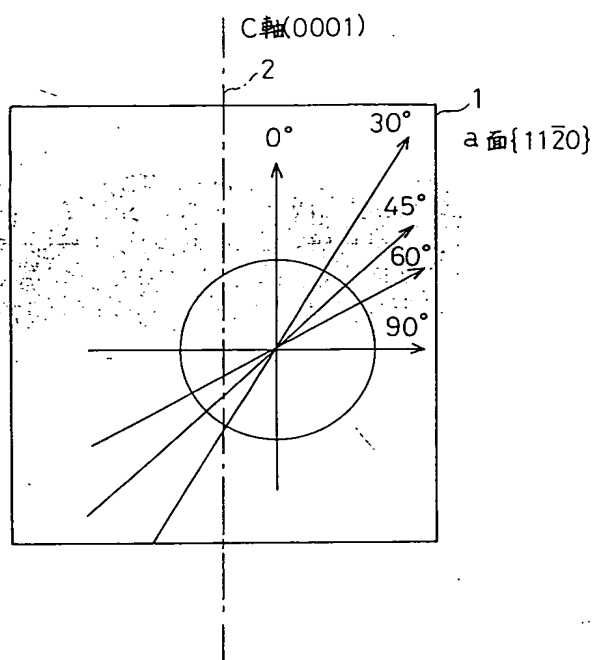
特許出願人

同

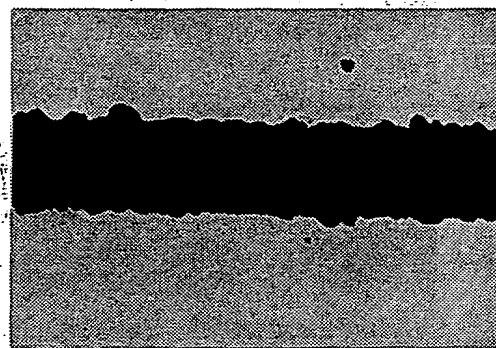
豊田合成株式会社  
新技術開発事業団

## BEST AVAILABLE COPY

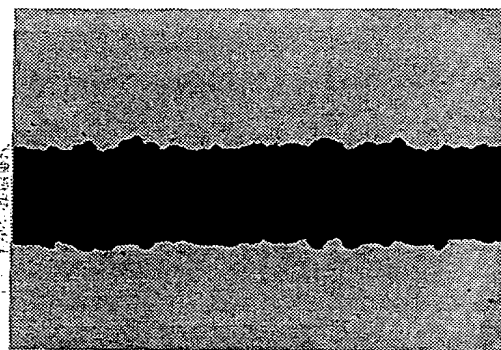
第 1 圖



第 2 圖

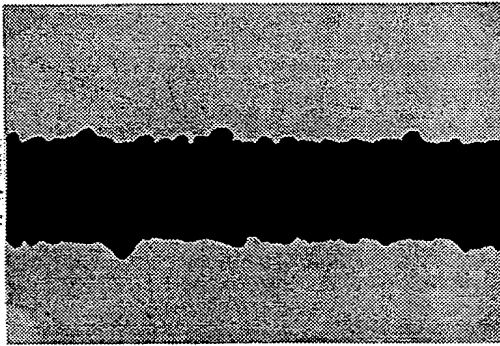


第 3 圖

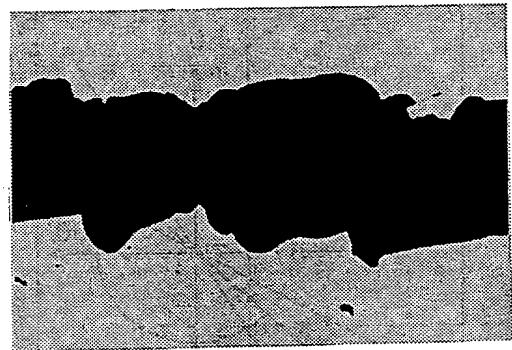


BEST AVAILABLE COPY

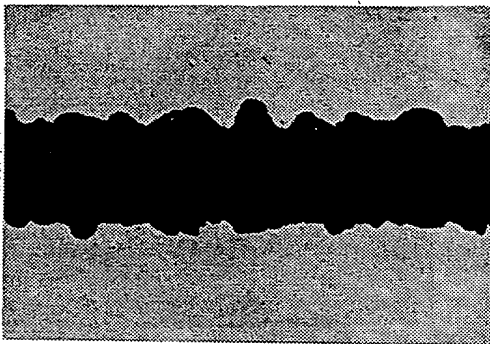
第 4 図



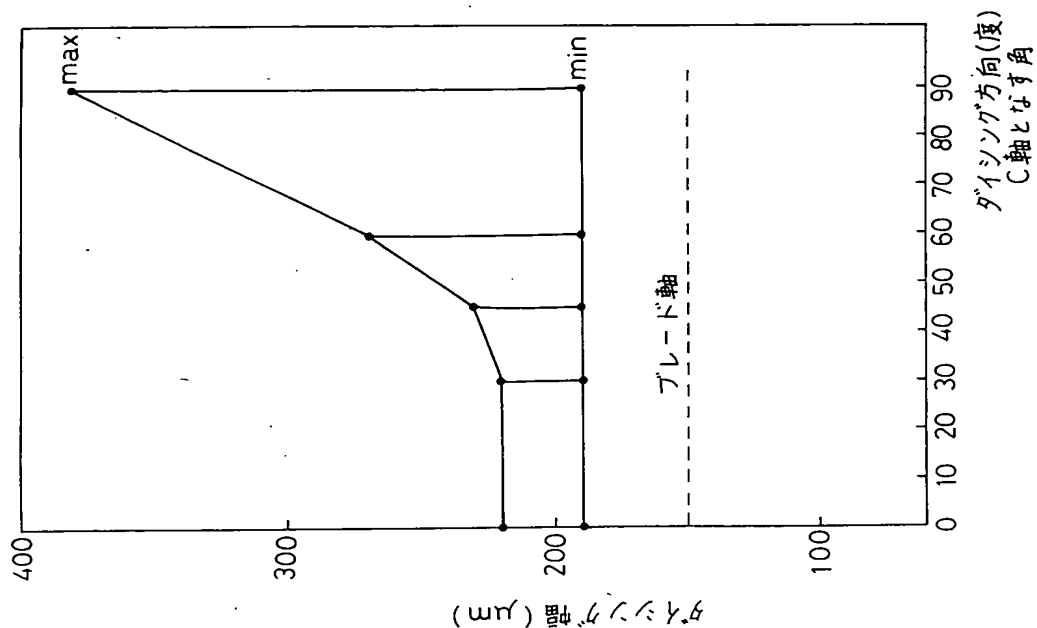
第 6 図



第 5 図



第7図



手続補正書(方式)

平成 1年 9月13日

特許庁長官 吉田 文毅 殿、

1. 事件の表示

平成 1年特許願第 1 1 0 9 6 5 号

2. 発明の名称

(1) サファイアを基板とする半導体チップの製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 東京都千代田区永田町二丁目 5 番 2 号

名称 新技術開発事業団

代表者 理事長 赤羽 信久

4. 代理人

住所 〒454  
愛知県名古屋市中川区一柳通 1 丁目 2 3 番地  
土屋ビル 3 F  
☎(052)363-2558

氏名 (8772) 弁理士 藤谷 修

5. 補正命令の日付(発送日)

平成 1年 8月14日(発送日 平成 1年 8月29日)

6. 補正の対象

- (1) 代理権を証明する書面
- (2) 明細書の図面の簡単な説明の欄
- (3) 図面 (第 2 ~ 第 6 図)

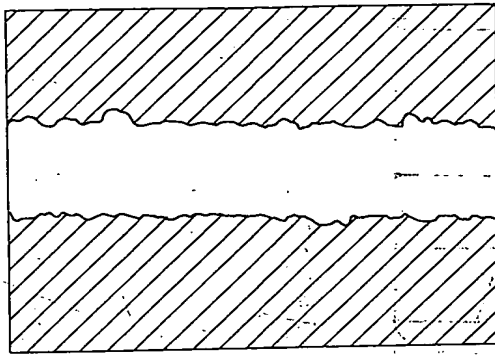
7. 補正の内容

- (1) 代理権を証明する書面の補充
- (2) 明細書の第 6 頁第 1 5 行目に「ダイシング溝を示した写真」とあるを「ダイシング溝を示した平面図」と訂正する。
- (3) 図面のうち第 2 図乃至第 6 図の図面に代わる写真を別紙の第 2 図乃至第 6 図の適正な図面に補正する。

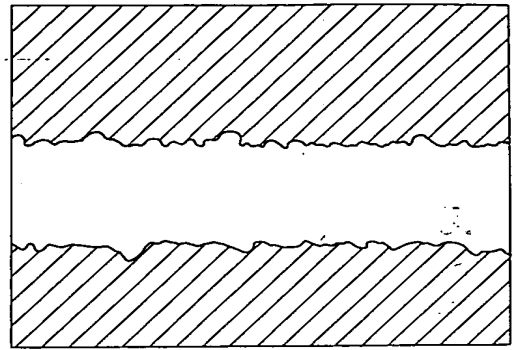
8. 添付書類の目録

- (1) 代理権を証明する書面 1 通
- (2) 適正な図面 (第 2 ~ 第 6 図) 3 通

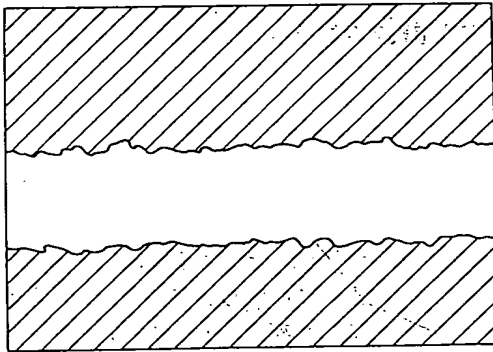
第 2 図



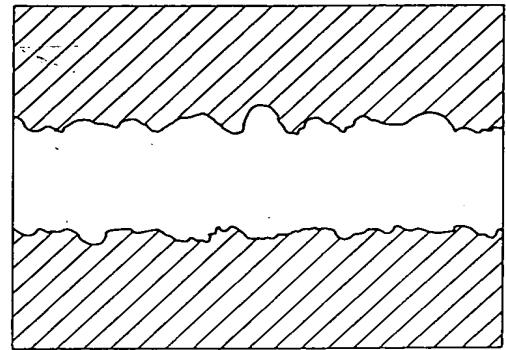
第 4 図



第 3 図



第 5 図



第 6 図

